

光电传感器/用于半导体工业的传感器摘要

M-DW1 晶片绘图传感器

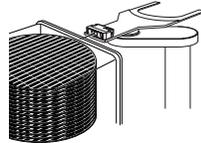


CE 标志 EMC指定适用

可检测涂氮晶片

- 激光绘图传感器具有危险，由于当从内部负载孔绘图时，激光光轴未达到FOUP直接射向操作员。使用LED光源的M-DW1比原先的激光光轴绘图传感器更安全。
- 涂氮晶片根据涂层厚度以一定波长吸收光线。如果传感器使用具有单个波长的传感器，光轴可能被完全吸收，导致晶片检测错误。M-DW1使用LED光源具有一定波长段，可始终成功地检测涂氮晶片。
- 根据反射光线的数量进行的晶片检测可能有时会由于晶片边缘的形状而发生错误。M-DW1在受光部分使用2个分隔的受光二极管，通过反射光线的位置而不是数量检测晶片。因此，传感器受晶片厚度或反射光线数量的影响较小。

晶片绘图检测



- 中心测量距离：45mm
- 电源电压：12~24V DC $\pm 10\%$
- 检测物体：3英寸以上半导体晶片
- 输出：NPN开路集电极晶体管(最大100mA)或PNP开路集电极晶体管(最大100mA)通过切换开关选择

M系列 晶片位置传感器

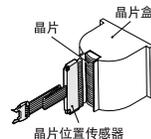


CE 标志 EMC指定适用

同时检测盒内的晶片

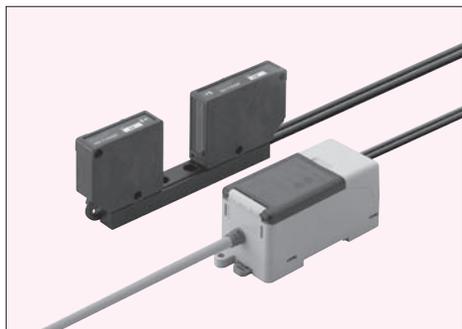
- 盒内的所有晶片都可被同时检测。
- 备有3种传感器：
 - M-625适用于25张6英寸晶片，
 - M-825适用于25张8英寸晶片，
 - M-826适用于26张8英寸晶片
- 由于是透过型，因此不受晶片表面颜色影响。

检测一叠晶片



- 晶片间距：6.35mm(M-825, M-826)
4.76mm(M-625)
- 电源电压：20~26.4V DC
- 输出：NPN开路集电极晶体管(最大20mA)

HD-T1 系列 LED型晶片校准传感器



CE 标志 EMC指定适用

使用安全的LED光确保分辨率 $30\mu\text{m}$ 下的高精度检测

- 使用安全的红色LED作为光源，无须费时的安全测量。使用激光时通常需要保护罩，在美国使用该传感器时不需要FDA认可。
- 虽然HD-T1系列使用红色LED作为光源，它具有激光传感器同样的高水平性能，因此确保高精度检测。
- 使用单触式连接器将检测头与控制器连接。减少电线使用量便于维修。

检测头

- 检测宽度：30mm
- 检测距离：30mm(固定)

控制器

- 电源电压：24V DC $\pm 10\%$
- 模拟输出：模拟电压 $1 \pm 0.5\text{V}$ (全遮光时)~ $5 \pm 0.5\text{V}$ (全入光时)